

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHJ8N60E-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V POWERPAK SO-8L</p>
	<p>Datenblätter:  SIHJ8N60E-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 953 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHJ8N60E-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V POWERPAK SO-8L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	953 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	520 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIHJ8N60E-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	754pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 8A (Tc) 89W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SIHJ8N60E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHJ8N60E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHJ8N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHJ8N60E-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHL520 V V TO-220</p>	 <p>SIHJ7N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SIHJ8N60E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SiHL540 Vishay Vishay TO-220</p>
 <p>SIHL510-E3 V V TO-220AB</p>	 <p>SIHJ6N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>	 <p>SiHL530S Vishay Vishay TO-263</p>	 <p>SIHJ6N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHJ8N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHJ8N60E-T1-GE3 Datenblatt	SIHJ8N60E-T1-GE3-Datenblätter	SIHJ8N60E-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHJ8N60E-T1-GE3
SIHJ8N60E-T1-GE3 Electronic	SIHJ8N60E-T1-GE3-Komponenten	SIHJ8N60E-T1-GE3-Verteiler	SIHJ8N60E-T1-GE3-Bild	SIHJ8N60E-T1-GE3-Teil
SIHJ8N60E-T1-GE3 Preis	SIHJ8N60E-T1-GE3 Hersteller	SIHJ8N60E-T1-GE3 Bild	SIHJ8N60E-T1-GE3 Aktie	SIHJ8N60E-T1-GE3 Inventar
SIHJ8N60E-T1-GE3 Neu	SIHJ8N60E-T1-GE3 Original	SIHJ8N60E-T1-GE3 garantiert	SIHJ8N60E-T1-GE3 RFQ	SIHJ8N60E-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited